

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Januar 2004 (08.01.2004)

PCT

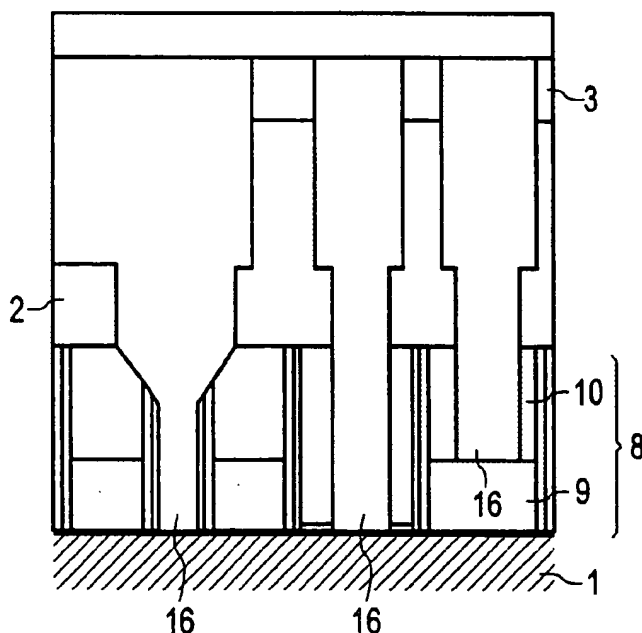
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/003998 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 21/768 (72) Erfinder; und
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002104 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DITTMAR, Lud-
(22) Internationales Anmeldedatum: 24. Juni 2003 (24.06.2003) wig [DE/DE]; Rossmähler Strasse 8, 01139 Dresden
(25) Einreichungssprache: Deutsch (DE). GUSTIN, Wolfgang [DE/DE]; Tichystrasse 4,
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch 01109 Dresden (DE). STEGEMANN, Maik [DE/DE];
(30) Angaben zur Priorität: 102 29 188.8 28. Juni 2002 (28.06.2002) DE Schunkstrasse 3, 01157 Dresden (DE).
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.- (DE, FR, GB, IE, IT).
Martin-Strasse 53, 81669 München (DE). Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR CONTACTING PARTS OF A COMPONENT INTEGRATED INTO A SEMICONDUCTOR SUB-
STRATE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON KONTAKTEN ZU TEILEN EINES IN EINEM HALBLEITER-
SUBSTRAT INTEGRIERTEN BAUELEMENTS



(57) Abstract: The invention relates to a method for contacting parts of a component integrated into a semiconductor substrate (1). According to the inventive method, a first contact hole is produced in an insulating layer (2), said contact hole being then filled with contact material (16) and connected to a line. The aim of the invention is to minimise the processes required for contacting parts of a component integrated into a semiconductor substrate. To this end, the hard mask (3) used to produce the contact hole is also used to structure the line.

(57) Zusammenfassung: Der Erfindung, die ein Verfahren zur Herstellung von Kontakten zu Teilen eines in einem Halbleitersubstrat (1) integrierten Bauelementes betrifft, bei dem in einer Isolationsschicht (2) ein erstes Kontaktloch erzeugt und mit Kontaktmaterial (16) gefüllt und mit einer Leitung verbunden wird, liegt die Aufgabe zugrunde, den Prozessaufwand bei der Kontaktierung von Teilen eines in einem Halbleitersubstrat integrierten Bauelementes zu minimieren. Dies wird dadurch gelöst, dass die für die Erzeugung des Kontaktloches verwendete Hartmaske (3) auch für die Strukturierung der Leitung eingesetzt wird.